

Сведения о ведущей организации

1.	Полное наименование организации	Акционерное общество «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники»
2.	Сокращенное наименование организации	АО «НИИМЭ»
3.	Ведомственная принадлежность	МИНПРОМТОРГ
4.	Место нахождения	г. Москва
5.	Почтовый адрес организации с указанием индекса	124460, Россия, Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд, 12/1
6.	Телефон с указанием кода города	+7 495 229 72 99
7.	Адрес электронной почты	niime@niime.ru
8.	Адрес официального сайта в сети «Интернет»	https://www.niime.ru
9.	Руководитель организации	Красников Геннадий Яковлевич
10.	Уполномоченный	Нечипоренко Александр Петрович
11.	Должность	Ученый секретарь
12.	Ученая степень	К.т.н.
13.	Ученое звание	
14.	Список основных публикаций работников ведущей организации по тематике диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	<p>1) Current relaxation analysis in AlGaIn/GaN high electron mobility transistors Polyakov A.Y., Smirnov N.B., Shchemerov I.V., Lee I.-H., Jang T., Dorofeev A.A., Gladysheva N.B., Kondratyev E.S., Turusova Y.A., Zinovyev R.A., Turutin A.V., Ren F., Pearton S.J. Journal of Vacuum Science and Technology B: Nanotechnology and Microelectronics, Volume 35, Issue 1, 1 January 2017, 011207</p> <p>2) Deep traps in AlGaIn/GaN high electron mobility transistors on SiC Polyakov A.Y., Smirnov N.B., Dorofeev A.A., Gladysheva N.B., Kondratyev E.S., Shemerov I.V., Turutin A.V., Ren F., Pearton S.J. ECS Journal of Solid State Science and Technology, Volume 5, Issue 10, 2016, Pages Q260-Q265</p> <p>3) ГЕНЕРАТОРЫ, УПРАВЛЯЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ, НА GAN ТРАЗИСТОРАХ Аболдуев И.М., Валамин Е.А., Дорофеев А.А., Зубков А.М., Миннебаев С.В., Царёв А.В., Кулиев М.В. Наноиндустрия. 2018. № 5 (82). С. 500-504.</p> <p>4) ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ АКТИВНОЙ ОБЛАСТИ ПТБШ НА ЕГО ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ</p>

	<p>Аболдуев И.М., Дорофеев А.А., Иванов К.А., Миннебаев В.М., Редька А.В., Царев А.В. Электронная техника. Серия 2: Полупроводниковые приборы. 2018. № 3 (250). С. 25-31.</p> <p>5) ВЛИЯНИЕ ТЕПЛООТВОДА С ПОВЕРХНОСТИ ПАССИВАЦИИ НА ЭФФЕКТ САМОРАЗОГРЕВА В ALGAN/GAN НЕМТ Турин В.О., Шадрин И.Ф., Дорофеев А.А., Баландин А.А. В сборнике: ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ - XXI ВЕК материалы XIII международной научно-практической интернет-конференции. ГУ «Орловский региональный центр Энергосбережения». 2015. С. 141-144.</p> <p>6) АНАЛИЗ ПРИБОРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЭПИТАКСИАЛЬНЫМ СТРУКТУРАМ GAN НА SI ДЛЯ СИЛОВЫХ И СВЧ-ПРИЛОЖЕНИЙ Баранов Г.В., Дорофеев А.А., Красников Г.Я., Леонеиков Е.И., Панасенко П.В. В книге: Международный форум "Микроэлектроника-2019" 5-я Международная научная конференция «Электронная компонентная база и микроэлектронные модули». Сборник тезисов Республика Крым, г. Алушта, 30 сентября – 05 октября 2019 г.. 2019. С. 147-148.</p> <p>7) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ В МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ Бокарев В.П., Красников Г.Я., Горнев Е.С. В книге: Международный форум "Микроэлектроника-2019" 5-я Международная научная конференция «Электронная компонентная база и микроэлектронные модули». Сборник тезисов Республика Крым, г. Алушта, 30 сентября – 05 октября 2019 г.. 2019. С. 148-150.</p> <p>8) АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ШЕРОХОВАТОСТЬ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР SI МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ Шарапов А.А., Баранов Г.В. Наноиндустрия. 2019. № S89. С. 232-233.</p> <p>9) ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОННОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ Грибов Б.Г. В книге: Международный форум "Микроэлектроника-2018", 4-я Международная научная конференция "Электронная компонентная база и микроэлектронные модули" Сборник тезисов. 2018. С. 28.</p> <p>10) СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ШЕРОХОВАТОСТИ НАНОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР Шарапов А.А., Баранов Г.В. Труды Московского физико-технического института. 2018. Т. 10. № 2 (38). С. 72-79.</p>
--	---

	<p>11) CHARGE TRANSPORT IN THIN LAYERS OF FERROELECTRIC $\text{Hf}_{0.5}\text{Zr}_{0.5}\text{O}_2$ Orlov O.M., Krasnikov G.Y., Islamov D.R., Perevalov T.V., Gritsenko V.A., Chernikova A.G., Kozodaev M.G., Markeev A.M. Russian Microelectronics. 2016. T. 45. № 5. С. 350-356.</p> <p>12) MECHANISM OF CHARGE TRANSPORT OF STRESS INDUCED LEAKAGE CURRENT AND TRAP NATURE IN THERMAL OXIDE ON SILICON Islamov D.R., Gritsenko V.A., Perevalov T.V., Orlov O.M., Krasnikov G.Y. Journal of Physics: Conference Series (см. в книгах). 2017. T. 864. № 1. С. 012003.</p> <p>13) КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ Бокарев В.П. Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника. 2016. № 2 (162). С. 56-59.</p> <p>14) АНИЗОТРОПИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. Бокарев В.П., Красников Г.Я. Электронная техника. Серия 3: Микроэлектроника. 2016. № 4 (164). С. 25-30.</p> <p>15) ФОРМИРОВАНИЕ МЕДНОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ С ULTRA LOW-K-ДИЭЛЕКТРИКОМ. Кузнецов П.И., Гвоздев В.А., Валеев А.С. В книге: Международная конференция "Микроэлектроника 2015" 2015. С. 277-278.</p>
--	--